

訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(編集部)

■ 2003年11月号

● FMEA & FTAのデバッグ手法…

p.266 図7: SW₂周辺を下図と差し替え

■ 2003年12月号

● 特集

p.124 写真F: 単色センサの写真のうち右下はRGB 3chカラー・センサ

p.147 左↓7行目: 除した値です。Pt100の0℃での…→除した値で、Pt100の0℃における…

p.177 図12(a): S9219の下のS1336→S9219

p.177 式(7): $t_3 = \frac{W}{V_d} = \dots$

p.181 写真1(a): S9032-02

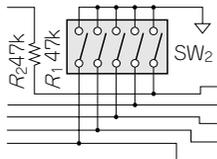
p.181 写真1(b): S7505-01は単色ではなくRGB3チャンネル・カラー・センサ
p.197 左↓16行目: 「SPR曲線は～しています。」の3行を「**4** SPR Curve」の前に移動

p.197 右↓1行目: 0, 1.0…→0, 0.5, 1.0…

p.197 右↓4行目: 共鳴角度→屈折率

p.197 右↓8行目: 共鳴角度→屈折率

p.198 図11のキャプション: 屈折率-



ブドウ糖重量濃度特性

p.198 図11: X軸は屈折率 [RIU] …, Y軸はブドウ糖重量濃度 [%]

p.198 図12: X軸は屈折率 [RIU]

● 低雑音OPアンプの使い方…

p.207 図2の説明文: T: 絶対温度 [K] [常温(300K)で計算…]

p.209 図4: 図中の式は以下のとおり

$$v_{IN} = \sqrt{(i_N + R_A G)^2 + (i_N - R_F)^2}$$

p.210 図7の説明文: ロックイン・アンプは…→雑音測定では…, B_{NX} を使ってDCからの雑音密度を…→ B_{NX} を使って雑音密度を

p.211 図8(b): 図中の式は以下のとおり

$$v_{Nin} = \sqrt{\frac{v_N^2 - (132 \times 10^{-9})^2 - v_{NLI}^2}{101}}$$

p.215 図23のキャプション: ゲイン2倍→ゲイン10倍

p.215 右↑10行目: (11)は引用文献

● FPGAによるΔΣ型A-D…

p.235 左↑5行目: DC→…→DC近傍…

p.236 図4: 1ビットD-Aコンバータの出力の白丸を削除

p.239 図9: EPF10K30ATC144の4番ピンの白丸を削除, 信号名はTDOではなくTDO

p.245 写真4のキャプション: 200 μs/div. …→(a)は500 μs/div., (b)~(g)は200 μs/div. …

● 100BASE-TXやADSLに…

p.255 右↑5行目: 直流信号を伝達～伝送する場合, 受信側で…→ベース・バ

ンド伝送方式による信号伝送では, 受信側で…

p.256 図6: $\Delta\mu = \dots \rightarrow \mu\Delta = \dots$

p.256 右↑18行目: $\Delta\mu$ と…→ $\mu\Delta$ と…

p.257 図7: Y軸はインダクタンス L [μH], 図中にある条件は「 $N = 22 T_S$, 評価形状: $T4 \times 2 \times 2 \text{ mm}$ 」

p.258 右↑8行目: 求めた磁束密度における増分透磁率 $\Delta\mu$ …→求めた磁界 H_{DC} における増分透磁率 $\mu\Delta$ …

p.258 式(5): 分子は $\mu_0 \mu\Delta \times N^2 \times A_e$

p.258 右↑3行目: $\Delta\mu$ …→ $\mu\Delta$ …

p.261 図18: 従来からの H_5C_2 材→従来からの H_5C_3 材

● バイパス・スイッチ内蔵アンプIC…

p.263 写真1: 下の写真と差し替え

p.266 左↑2行目: 図8(b)から…→図8(d)から…

p.267 図8: (a)と(d)の縦軸の数値は下から順に 1, 3, 5, 7, 9

p.268 図11: (a)と(d)の縦軸の数値は下から順に 1, 3, 5, 7, 9

